

Liste des tableaux

<i>Chapitre I : Propriétés des composées II-VI</i>		
Tableau I-1	Type d'énergie de gap des semi-conducteurs II-VI	8
Tableau I-2	Propriétés des composés binaires ZnO, ZnS et ZnTe	10
<i>Chapitre III : Résultats de simulation et discussion</i>		
Tableau III-1	les paramètres, le groupe d'espace et les nombres atomiques du composée ZnX(X=O,S,Te) à base de Zinc.	29
Tableau III-2	les valeurs de convergence des ZnTe, ZnS et ZnO par l'approximation LDA et GGA.	34
Tableau III-3	Les valeurs des paramètres optimisés par le code CASTEP des matériaux ZnO, ZnS, ZnTe.	35
Tableau III-4	Les propriétés structurales de ZnO, ZnS, ZnTe, les paramètre du maille, le Volume et le module de compressibilité B_0 .	37
Tableau III-5	: Largeur de la bande interdite calculé comparée à d'autres résultats théoriques et expérimentaux pour ZnO, ZnS, ZnTe.	41
Tableau III-(a)	Les valeurs des coefficients d'absorption α_0 .	43
Tableau III-6	Valeurs des coefficients de réflectivité R_0 pour les composées ZnO, ZnS, ZnTe pour deux approximations GGA et LDA.	45
Tableau III-7	Valeurs de la partie réelle du coefficient de conductivité $\sigma(\omega)$.	47

Tableau III-8	Valeurs de la partie réelle du constant diélectrique $\epsilon(0)$ pour les composés ZnX (X = O, S, Te).	49
Tableau III-9	Valeurs de l'indice de réfraction n_0 pour les composés ZnX (X = O, S, Te) pour les approximations LDA et GGA.	52
Chapitre IV : Applications aux cellules solaires en couches minces		
Tableau IV-1	Paramètres des différentes couches des deux structures étudiées.	63